

а 2007 0303

Изобретение относится к производству полупроводников.

Способ получения полупроводниковых наноструктурных зон включает осаждение, на одну из поверхностей полупроводникового кристалла, маски с открытым участком, электрохимическое травление при анодировании в водном растворе NaCl и удаление маски.

Результат изобретения состоит в получении полупроводниковых наноструктурных зон с морфологией, регулируемой концентрацией раствора NaCl и применяемыми электрическими параметрами, используя раствор NaCl который не представляет опасность для здоровья персонала или для окружающей среды.

П. формулы: 1

Фиг.: 4